

интервал $\Delta x = 4\pi \sin \theta / (\lambda_{\max} - \lambda_{\min})$. При этом интегральная интенсивность рефлекса:

$$I(h, k, l) = \Phi(\lambda) \frac{\lambda^4}{2 \sin^2 \theta} \frac{|F(h, k, l)|^2}{V_c} A(\lambda, \theta) Y(\lambda, \theta),$$

где $\Phi(\lambda)$ — спектральная плотность потока нейтронов, падающих на образец; ЭВМ управляет положениями

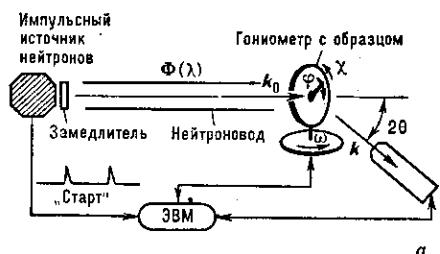


Рис. 2. а — схема дифрактометра по времени пролёта на импульсном источнике нейтронов; б — построение Эвальда.

образца и детектора и организует накопление и обработку эксперим. данных.

Разрешающая способность нейтронных дифрактометров $\Delta H/H \sim 10^{-2}$, в дифрактометрах высокого разрешения $\Delta H/H \sim 5 \times 10^{-4}$. При этом параметры элементарной ячейки кристалла определяются с относит. точностью $\sim 5 \times 10^{-5}$ и достигается практическое полное разделение упругого и неупругого компонентов в рассеянном нейтронном пучке (см. Неупругое рассеяние нейтронов).

На рис. 3 приведено распределение $\rho(r)$ в кристалле KH_2PO_4 вблизи водородной связи $\text{O} - \text{H} - \text{O}$. Смеще-

и ближний порядок). Для описания ближнего порядка используется корреляция. Ф-ция $g(r)$, имеющая смысл вероятности обнаружить к.-л. ядро в точке r (в объёме dV), если др. ядро находится в начале координат. Дифференц. сечение когерентного рассеяния (в случае атомов одного сорта) имеет вид

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = b^2 \left[1 + \int_V g(r) \exp(i\mathbf{k}r) dV \right]$$

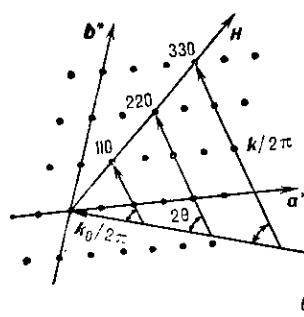
или после усреднения по ориентациям (для изотропного вещества)

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = b^2 \left[1 + 4\pi \int g(r) \frac{\sin(\mathbf{k}r)}{\mathbf{k}r} r^2 dr \right]. \quad (3)$$

Ф-ция $g(r)$ может быть найдена из (3) с помощью обратного преобразования Фурье.

Если вещество содержит атомы неск. видов (α и β), то $g(r)$ можно представить в виде суперпозиции парциальных корреляций. Ф-ции $g_{\alpha\beta}(r)$, описывающих распределение расстояний между атомами сортов α и β . Парциальные ф-ции $g_{\alpha\beta}$ в сечение рассеяния входят в качестве слагаемых с коэф., пропорциональными произведению соответствующих когерентных амплитуд рассеяния b_α и b_β . Это позволяет использовать для нахождения $g_{\alpha\beta}$ т. н. изотопное замещение. Напр., при исследовании структуры воды выделяют 3 вида расстояний: $\text{H} - \text{H}$, $\text{O} - \text{O}$ и $\text{H} - \text{O}$, к-рые удаётся определить, изучая рассеяние нейтронов в смесях $\text{H}_2\text{O} - \text{D}_2\text{O}$. Таким способом были исследованы структуры ряда электролитов (напр., растворы NiCl_2 , CaCl_2 в воде), аморфных металлов и др. аморфных веществ. Замещение H на D оказалось эффективным при исследовании структуры жидких кристаллов и фазовых превращений в них.

Разбавленные растворы макромолекул и молекулярные газы. Выражение (1) для интенсивности в этом случае остаётся в силе, однако интегрирование можно ограничить объёмом одной молекулы или макромоле-



б

тически полное разделение упругого и неупругого компонентов в рассеянном нейтронном пучке (см. Неупругое рассеяние нейтронов).

На рис. 3 приведено распределение $\rho(r)$ в кристалле KH_2PO_4 вблизи водородной связи $\text{O} - \text{H} - \text{O}$. Смеще-

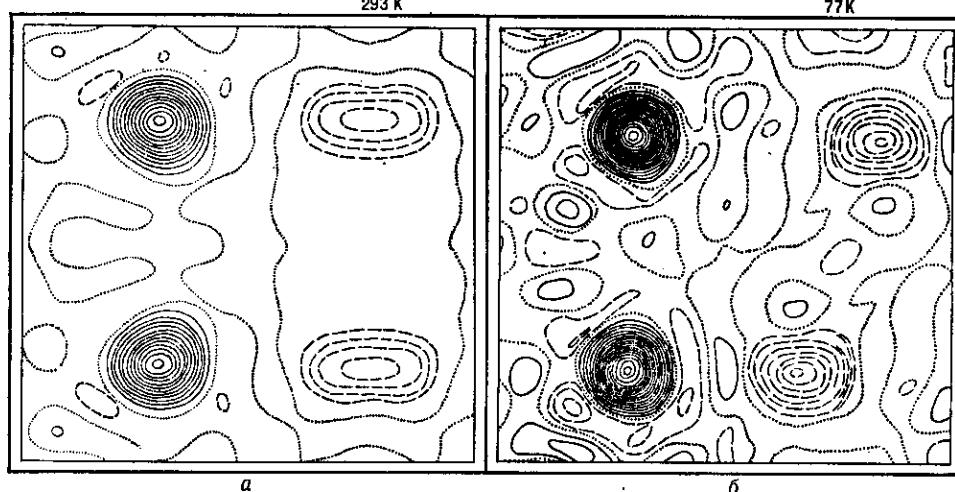


Рис. 3. Фрагмент проекции плотности амплитуды рассеяния $\rho(r)$ на плоскость (001) в кристалле KH_2PO_4 при $T = 293$ К (а) и $T = 77$ К (б). Показаны 2 атома О ($\rho > 0$, непрерывные линии) и два атома Н ($\rho < 0$, разрывные линии); точки соответствуют $\rho = 0$.

ние Н ($b = -0,374 \cdot 10^{-12}$ см) к одному из атомов О при $T = 77$ К связано с фазовым переходом KH_2PO_4 в сегнетоэлектрич. состояние.

Аморфные тела и жидкости не обладают дальним порядком в расположении атомов, но обладают ближним порядком — нек-рой упорядоченностью на расстояниях, сравнимых с размерами атомов (см. Дальний

и ближний порядок). Когерентное рассеяние в основном происходит при углах $\theta < \lambda/R$, где R — характерный размер частицы, и быстро затухает с увеличением θ . В случае макромолекул обычно $R \gg \lambda$ и рассеяние сосредоточено в области малых θ (см. Малоугловое рассеяние). Из зависимости $I(x)$ можно извлечь информацию о разме-

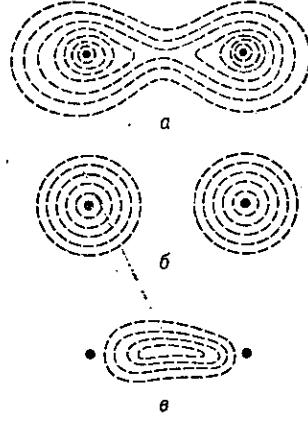


Рис. 4. а — электронная плотность, определённая методом РСА; б — вычисленная по нейтронным данным для сферически-симметричного атомного фактора; в — разностная плотность.